

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 17 年 9 月 15 日 (2005.9.15)

【公開番号】特開 2005-39198 (P2005-39198A)

【公開日】平成 17 年 2 月 10 日 (2005.2.10)

【年通号数】公開・登録公報 2005-006

【出願番号】特願 2004-92281 (P2004-92281)

【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/304

H 0 1 L 21/3205

H 0 1 L 27/14

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 4 7 Z

H 0 1 L 21/304 6 4 7 A

H 0 1 L 21/304 6 4 8 Z

H 0 1 L 21/88 B

H 0 1 L 27/14 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 6 月 6 日 (2005.6.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 4】

請求項 1、2 又は 3 記載の半導体装置の洗浄方法において、前記半導体装置が、シリコン (Si)、シリコン - オン - インシュレータ (SOI)、シリコン - ゲルマニウム (Si - Ge)、炭化シリコン (SiC) および III - V 族化合物などの化合物半導体から選ばれる少なくとも 1 つの材料からなることを特徴とする半導体装置の洗浄方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

〔4〕上記〔1〕、〔2〕又は〔3〕記載の半導体装置の洗浄方法において、前記半導体装置が、シリコン (Si)、シリコン - オン - インシュレータ (SOI)、シリコン - ゲルマニウム (Si - Ge)、炭化シリコン (SiC) および III - V 族化合物などの化合物半導体から選ばれる少なくとも 1 つの材料からなることを特徴とする。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0073

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0073】

半導体層としては、特に限定はしないが、例えば、単結晶シリコン、多結晶シリコン、非晶質シリコンなどのシリコン (Si)、シリコン - オン - インシュレータ (SOI)、シリコン - ゲルマニウム (Si - Ge)、炭化シリコン (SiC) および III - V 族化合

物などの化合物半導体層などが使用できる。また、III - V 族化合物半導体層としては、例えば、砒化ガリウム (GaAs) やリン化インジウム (InP) などの層が挙げられる。